

平成30年度 公益社団法人 応用物理学会 北陸・信越支部 講演会

入場
無料

日時 平成30年7月2日(月) 16:30~18:00

場所 金沢大学 角間キャンパス
自然科学大講義棟レクチャーホール
(石川県金沢市角間町)

演題 電子デバイスにおけるMOS界面の重要性と制御技術

講師 山部 紀久夫 特命教授(筑波大学)

講演内容:

MOSデバイスの初期特性および信頼性のいずれにおいても、ゲート酸化膜の界面および膜質が重要な役割を果たす。半導体/絶縁膜界面近傍を電荷が流れるMOSデバイスでは、特に絶縁膜技術の重要性は高い。シリコンMOSFETでは、当初より不純物など多くの課題が指摘されつつも、世代世代の最大課題を克服してきた。一方で、熱酸化という容易な形成技術ゆえに、材料・プロセスなど種々の周辺技術の監視役を果たしてきた。結果、最先端の不揮発性メモリでは、もはや数nm厚に達し、原子レベルの制御性が求められている。

講演では、これまでの開発の歴史を簡単に総括する。

問い合わせ先 川江 健 金沢大学理工研究域電子情報学系
TEL:076-234-4881